

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年12月13日(2012.12.13)

【公開番号】特開2011-157596(P2011-157596A)

【公開日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【年通号数】公開・登録公報2011-033

【出願番号】特願2010-20657(P2010-20657)

【国際特許分類】

C 25 D 1/00 (2006.01)

G 01 R 1/073 (2006.01)

G 01 R 1/067 (2006.01)

【F I】

C 25 D 1/00 3 8 1

G 01 R 1/073 F

G 01 R 1/067 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月22日(2012.10.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ベース基板上に犠牲層を形成する工程と、

前記犠牲層上にレジスト層を形成する工程と、

前記レジスト層にデバイスの形状に対応する開口と、前記デバイスを取り囲むフレームの形状に対応する開口を形成する工程と、

前記レジスト層に設けた前記デバイスの形状に対応する開口および前記フレームの形状に対応する開口に導電性金属材料を充填し、前記デバイスと前記フレームを形成する工程と、

前記犠牲層の上に形成されたレジスト層を除去し、前記犠牲層を除去する工程を含み、

前記犠牲層が除去されて前記デバイスが前記ベース基板上へと移動された時に、前記フレーム内に前記デバイスが位置し、前記デバイスは前記フレームによって水平方向の移動が制限されていることを特徴とするMEMSデバイスの製造方法。